# Магнитооптическая спектроскопия и оптическое детектирование ЭПР парамагнитных центров Yb<sup>3+</sup> кубической симметрии в монокристаллах MeF<sub>2</sub> (Me = Cd, Ca, Pb)

© К.И. Герасимов, М.Л. Фалин

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Российской академии наук, Казань, Россия E-mail: falin@kfti.knc.ru

# (Поступила в Редакцию 21 мая 2008 г.)

В кристаллах типа флюорита MeF<sub>2</sub> (Me = Cd, Ca, Pb) проведено исследование парамагнитных центров кубической симметрии, образуемых примесным ионом Yb<sup>3+</sup>, методами ЭПР, магнитного циркулярного дихроизма и циркулярной поляризации люминесценции, зеемановских расщеплений оптических линий поглощения и люминесценции, оптического детектирования ЭПР. Определены *g*-факторы состояния  ${}^{2}\Gamma_{7}$  в возбужденном мультиплете  ${}^{2}F_{5/2}$  Yb<sup>3+</sup> в MeF<sub>2</sub>, константа сверхтонкого взаимодействия  ${}^{171}A$  ( ${}^{171}Yb$ ) в возбужденном мультиплете  ${}^{2}F_{5/2}$  g CaF<sub>2</sub>, значения энергий и свойства симметрии всех энергетических уровней Yb<sup>3+</sup> в MeF<sub>2</sub>. Вычислены параметры кристаллического поля в исследуемых кристаллах.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 06-02-17481), Министерства образования и науки РФ (РНП 2.2.2.3.1091) и фонда CRDF (программа BRHE N Y3-P-07-03).

PACS: 71.70.-d, 76.30.Kg, 76.70.Hb, 78.30.Hv

# 1. Введение

Кристаллы структурного ряда флюорита MeF<sub>2</sub> (Me = Cd, Ca, Sr, Pb, Ba), активированные редкоземельными ионами (РЗИ), с одной стороны, находят широкое практическое применение (сцинцилляторы, ионные проводники, материалы квантовой электроники и т.д.), а с другой стороны, на протяжении многих лет являются модельными объектами экспериментальных и теоретических исследований. Кристаллы имеют кубическую кристаллическую решетку и легко активируются РЗИ, образуя парамагнитные центры (ПЦ) как кубической, так и более низкой симметрии. Примером модельной системы являются кристаллы MeF<sub>2</sub>, активированные Yb<sup>3+</sup>. Данный ион имеет основную электронную конфигурацию —  $4f^{13}$  — и соответственно простую схему энергетических уровней (только один терм  ${}^{2}F$ ). В кристаллическом поле кубической симметрии основной (2F7/2) и возбужденный  $({}^{2}F_{5/2})$  мультиплеты расщепляются на три  $({}^{1}\Gamma_{7}, {}^{1}\Gamma_{8}, \Gamma_{6})$ и два  $({}^{2}\Gamma_{7}, {}^{2}\Gamma_{8})$  энергетических уровня соответственно. Экспериентальная информация о таких модельных системах имеет особое значение для развития и апробации новых теоретических представлений о характере взаимодействий ионов в кристалле и природе дефектообразования [1–4]. ПЦ кубической симметрии (T<sub>c</sub>) в таких расчетах, как правило, служат отправной точкой, и полнота экспериментальной информации о таких ПЦ имеет большое значение. Известно, что трехвалентные ионы иттербия образуют Т<sub>с</sub> во всей структурной серии кристаллов типа флюорита. Несмотря на то что Т<sub>с</sub> в данных кристаллах интенсивно изучались методами магнитного резонанса [4], магнитооптики [5] и оптической спектроскопии [6-12], информация о штарковской структуре энергетических уровней не является достаточно полной для определения надежных феноменологических параметров кристаллического поля (КП). Например, для  $CaF_2$ , SrF<sub>2</sub>, PbF<sub>2</sub> и BaF<sub>2</sub> имеется неопределенность в экспериментальном значении энергии Г<sub>6</sub>. В CdF<sub>2</sub> из спектров поглощения установлены значения энергий уровней верхнего ( ${}^{2}F_{5/2}$ ) мультиплета для  $T_{c}$  [11]. Сведения об энергетических уровнях нижнего мультиплета  $({}^{2}F_{7/2})$  из спектров люминесценции Yb<sup>3+</sup> в этом кристалле неоднозначны [12], поскольку в данной работе отсутствуют какие-либо сведения о типах ПЦ в кристалле, а предложенные несколько вариантов значений энергий уровней не согласуются с соответствующими значениями для T<sub>c</sub> в остальных кристаллах MeF<sub>2</sub>. Это в свою очередь не позволило определить параметры КП для  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub>.

Настоящая работа представляет детальные исследования  $Yb^{3+}$  ( $T_c$ ) в кристаллах CdF<sub>2</sub>, CaF<sub>2</sub> и PbF<sub>2</sub> методами ЭПР, оптической и магнитооптической спектроскопии, включая оптическое детектирование ЭПР (ОД ЭПР).

### 2. Экспериментальные результаты

Кристаллы MeF<sub>2</sub> (Me = Cd, Pb, Ca) были выращены методом Бриджмена–Стокбаргера в графитовых тиглях в атмосфере фтора. Активация кристаллов осуществлялась введением YbF<sub>3</sub> в шихту. Далее под концентрацией (c) Yb<sup>3+</sup> понимается количество YbF<sub>3</sub> в шихте в процентном отношении.

Измерения ЭПР проводились на модифицированном спектрометре ERS-231 (Германия) [13] при *T* = 4.2 K. Оптико-магнитные спектры (оптические, магнитной циркулярной поляризации люминесценции — МЦПЛ, зе-



**Рис. 1.** Спектры люминесценции (a-c) и поглощения (d) Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> (концентрации YbF<sub>3</sub> указаны около спектров). T = 2 K. На вставках справа показаны фрагменты спектров люминесценции (спектры нормированы на значение наиболее интенсивной линии в данной области), слева — схема энергетических уровней Yb<sup>3+</sup> ( $T_c$ ).

емановского расщепления линий поглощения и люминесценции, ОД ЭПР) регистрировались на многофункциональном спектрометре [14] при T = 2, 4.2, 77и 300 К. Спектры люминесценции измерялись как при возбуждении светом ксеноновой лампы высокого давления, так и при селективном возбуждении. В качестве источника селективного возбуждения люминесценции использовался полупроводниковый лазерный диод АТС-С1000-100-ТМГ-965 (Санкт-Петербург) мощностью 1 W с шириной линии излучения порядка 2 nm и возможностью перестройки длины волны излучения от 963 nm  $(10\,381\,\text{cm}^{-1})$  до 969 nm  $(10\,317\,\text{cm}^{-1})$ . Для наблюдения спектров ОДЭПР исследуемый образец помещался в пучность магнитной компоненты СВЧ-волны прямоугольного резонатора  $TE_{102}$  с отверстиями (d = 4 mm) для прохождения света. Оптический гелиевый криостат с резонатором находился в межполюсном зазоре электромагнита (80 mm). Для возбуждения и регистрации люминесценции вдоль направления магнитного поля использовались 90° призмы. Источником СВЧ-накачки служил клистрон K-88A на  $9.5 \,\text{GHz}$  ( $W = 800 \,\text{mW}$ ). В качестве анализатора поляризации люминесценции применялись ячейки Поккельса и поляризатор, в остальном при регистрации спектров ОД ЭПР использовалась стандартная методика [15,16]. Экспериментальные значения длин волн линий люминесценции и поглощения переводились в длины волн в вакууме. Соотношение ( $\lambda_{vac} = 0.006342 + 1.000267\lambda$ ), по которому делался этот перевод, было получено линейной аппроксимацией данных [17]. Далее длины волн и частоты оптических линий в тексте и на рисунках приведены с учетом данного перевода.

На рис. 1 представлены спектры люминесценции и поглощения Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> при различных концентрациях иттербия (c = 0.001, 0.01 и 0.1%), на вставке рисунка показана диаграмма энергетических уровней Т<sub>с</sub>. При c = 0.001% в области частот  $10\,360 - 10\,400\,\mathrm{cm}^{-1}$  наблюдаются две линии люминесценции. Согласно [11], наиболее интенсивная из них принадлежит T<sub>c</sub> Yb<sup>3+</sup> (переход  ${}^{1}\Gamma_{7} \leftrightarrow {}^{2}\Gamma_{7}$ ), а вторая — ПЦ ромбической симметрии  $Yb^{3+}$  ( $R_{Na^+}$ ). Однако в работе [11] данная линия наблюдалась в спектрах поглощения кристаллов, синтезированных с добавкой NaF. В нашем случае эта линия наблюдается для кристаллов, выращенных без специальных добавок. Для подтверждения предположения о принадлежности данной линии R<sub>Na<sup>+</sup></sub> были проведены исследования кристаллов CdF2: 0.001%  $YbF_3$  и  $CdF_2$ : 0.001%  $YbF_3$  + 0.01% NaF методом ЭПР. В обоих случаях угловые зависимости спектров ЭПР в плоскости (110) (рис. 2) показали, что в указанных кристаллах присутствуют центры  $T_c$  (g = 4.329) с нелокальной компенсацией избыточного положительного заряда и шесть магнитонеэквивалентных комплексов ромбической симметрии R<sub>Na<sup>+</sup></sub> с ионом-компенсатором Na<sup>+</sup>, замещающим ближайший к Yb<sup>3+</sup> катион вдоль оси С2 кристаллической решетки. Следует отметить



**Рис. 2.** Угловая зависимость спектров ЭПР Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> при вращении магнитного поля в плоскости (110). T = 4.2 K,  $\nu = 9.33$  GHz. Штриховые линии — теоретическая аппроксимация линий ЭПР (<sup>even</sup>Yb), соответствующих ПЦ  $R_{\text{Na}^+}$ . На вставках показаны фрагменты структурных моделей ПЦ  $T_c$  и  $R_{\text{Na}^+}$  Сверхтонкая структура Yb<sup>3+</sup> ( $T_c$ ) показана на нижней вставке, где числа соответствуют изотопам <sup>171</sup>Yb (I = 1/2) и <sup>173</sup>Yb (I = 5/2).

Уровень	$CdF_2$		CaF <sub>2</sub>		PbF <sub>2</sub>	
	Эксперимент	Теория	Эксперимент	Теория	Эксперимент	Теория
$^{2}\Gamma_{8}$	10867	10871	10840	10848	10761	10764
$^{2}\Gamma_{7}$	10392	10374	10381	10343	10346	10333
$g(^{2}\Gamma_{7})$ — Зееман	$-1.42\pm0.07$	-1.396	$-1.42\pm0.07$	-1.401	$-1.43\pm0.07$	-1.403
$g(^{2}\Gamma_{7})$ — ОД ЭПР	$-1.411 \pm 0.006$		$-1.414 \pm 0.004$		$-1.414\pm0.005$	
$^{171}A(^{2}\Gamma_{7})$ — ОД ЭПР			$2759\pm30$			
$\Gamma_6$	755	741	778	749	642	632
${}^{1}\Gamma_{8}$	676	669	644	629	561	556
${}^{1}\Gamma_{7}$	0	0	0	0	0	0
$g({}^{1}\Gamma_{7})$ — ЭПР	$3.429 \pm 0.001$	3.484	$3.438\pm0.005$	3.480	$3.429 \pm 0.001$	3.476
$^{171}A(^{1}\Gamma_{7})$ — ЭПР	$2642\pm5$		$2638.70 \pm 0.05  [18]^*$		$2650\pm5$	

Таблица 1. Уровни энергии (сm<sup>-1</sup>),  ${}^{171}A$  (MHz) и *g*-факторы Yb<sup>3+</sup> ( $T_c$ ) в кристаллах MeF<sub>2</sub>.

\* Получено из эксперимента по ДЭЯР.

довольно заметное отличие полученных значений g-факторов  $R_{\text{Na}^+}$  ( $g_x = 3.300, g_y = 3.218, g_z = 3.737$ ) от приведенных в [11]:  $g_x = 3.356, g_y = 3.271, g_z = 3.775$ . Для кристалла, выращенного с добавкой NaF в спектрах люминесценции наблюдается значительное увеличение интенсивности линии 10 385 сm<sup>-1</sup>, что подтверждает предположение о принадлежности данной линии  $R_{\text{Na}^+}$ , а ее наличие в спектре люминесценции кристалла CdF<sub>2</sub>: 0.001% YbF<sub>3</sub>, видимо, свидетельствует о присутствии неконтролируемой примеси NaF в шихте.

При более высоких концентрациях YbF<sub>3</sub> (0.01 и 0.1%) в области частот 10190-10250 cm<sup>-1</sup> в спектрах люминесценции и поглощения наблюдается группа линий. Интенсивность этих линий по отношению к интенсивности линии ПЦ кубической симметрии растет с концентрацией. При селективном возбуждении люминесценции на частотах данных линий наблюдается интенсивная апконверсионная люминесценция в видимой области спектра. С учетом этого указанные линии, видимо, соответствуют парным центрам или кластерам иттербия. С увеличением концентрации в области 10 360-10 400 cm<sup>-1</sup> (вставка к рис. 1) как в спектрах люминесценции, так и в спектрах поглощения появляются дополнительные линии, соответствующие другим ПЦ, образование которых, видимо, связано с различными вариантами локальной компенсации избыточного положительного заряда. Для установления структурных моделей этих ПЦ требуются более детальные исследования.

Спектры люминесценции Yb<sup>3+</sup> при селективном возбуждении на частотах 10 392, 10 381 и 10 346 cm<sup>-1</sup> для CdF<sub>2</sub>, CaF<sub>2</sub> и PbF<sub>2</sub> соответственно представлены на рис. 3. Область излучения лазерного диода схематически показана горизонтальной скобкой в нижней части каждого спектра. Методом оптической Зееманспектроскопии [5] было показано, что линия поглощения 10 381 cm<sup>-1</sup> в CaF<sub>2</sub> соответствует переходу  ${}^{1}\Gamma_{7} \leftrightarrow {}^{2}\Gamma_{7}$  Yb<sup>3+</sup> ( $T_{c}$ ). По аналогии можно предположить, что линии 10 392 и 10 346 cm<sup>-1</sup> в CdF<sub>2</sub> и PbF<sub>2</sub> соответственно также принадлежат этому переходу. Для доказательства этого предположения были проведены исследования поперечного и продольного эффектов Зеемана для линий люминесценции с частотами 10392, 10381 и 10346 сm<sup>-1</sup>. Угловые зависимости величин расщепления в магнитном поле данных линий люминесценции имеют изотропный характер, что доказывает их принадлежность  $T_c$  и переходу  ${}^1\Gamma_7 \leftrightarrow {}^2\Gamma_7$ . Величины расщеплений и интенсивности  $\pi$ - (E || H, где E электрический вектор световой волны, H — направление магнитного поля) и  $\sigma$ - (E  $\perp$  H) компонент в зеемановских спектрах позволили определить значения g-факторов для состояния  ${}^2\Gamma_7$  в возбужденном муль-



**Рис. 3.** Спектры люминесценции Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> (c = 0.01%), CaF<sub>2</sub> (c = 0.01%) и PbF<sub>2</sub> (c = 0.03%) при селективном возбуждении лазерным диодом, области излучения которого схематически показаны горизонтальной скобкой. T = 2 К. Стрелками показаны линии люминесценции  $T_c$ , соотнесенные с электронными переходами с соответствующим обозначением.



**Рис. 4.** Спектры МЦПЛ  $(I(\sigma_r)-I(\sigma_l))$  Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> (c = 0.01%), CaF<sub>2</sub> (c = 0.01%) и PbF<sub>2</sub> (c = 0.03%) при селективном возбуждении (условия возбуждения соответствуют рис. 3) излучением лазерного диода с линейной поляризацией  $(\pi)$  и с циркулярной поляризацией с правым  $(\sigma_r)$  и левым  $(\sigma_l)$  вращением. T = 2 K, H = 800 mT.

типлете  ${}^{2}F_{5/2}$  (табл. 1). Из сравнения величин зеемановских расщеплений линий люминесценции в поперечной и продольной геометрии эксперимента установлено, что данные линии соответствуют магнитным дипольным переходам (в продольной геометрии эксперимента наблюдаются линии, соответствующие  $\pi$ -переходам в поперечном эффекте Зеемана), и знак *g*-фактора уровня  ${}^{2}\Gamma_{7}$  имеет противоположную величину по отношению к знаку *g*-фактора уровня  ${}^{1}\Gamma_{7}$ . Следует отметить, что выводы о мультипольности переходов и знаке *g*-фактора состояния  ${}^{2}\Gamma_{7}$  находятся в согласии с результатами, полученными в работах [19–21] для изоэлектронного иона Tm<sup>2+</sup> в CaF<sub>2</sub>.

Для определения более точных значений g-факторов состояния <sup>2</sup>Г<sub>7</sub> были проведены измерения спектров ОД ЭПР по МЦПЛ. Спектры МЦПЛ Yb<sup>3+</sup> в MeF<sub>2</sub> при различной поляризации излучения, возбуждающего люминесценцию, представлены на рис. 4. Для кристаллов PbF2 и CaF2 ярко выражен эффект спиновой памяти [15], который в данном случае проявляется в том, что при возбуждении люминесценции вдоль направления магнитного поля светом с циркулярной поляризацией люминесценция также имеет циркулярную поляризацию преимущественно с правым или левым вращением в зависимости от направления вращения поляризации возбуждающего света. Для CdF2 этот эффект также присутствует, хотя он не так ярко выражен, что, видимо, свидетельствует о более коротком времени спинрешеточной релаксации на состоянии  ${}^{2}\Gamma_{7}$  в кристалле по сравнению с PbF<sub>2</sub> или CaF<sub>2</sub>. Наличие данного эффекта позволяет, используя возбуждающее излучение с правым или левым вращением поляризации, преимущественно заселить один из двух зеемановских подуровней состояния  ${}^{2}\Gamma_{7}$ . Это использовалось при регистрации спектров ОД ЭПР для увеличения сигнала микроволнового резонанса.

Спектр ОДЭПР Yb<sup>3+</sup> для состояния  ${}^{2}\Gamma_{7}$  в CaF<sub>2</sub> представлен на рис. 5. Интенсивная линия соответствует четным изотопам Yb<sup>3+</sup>, две линии ОДЭПР с меньшей интенсивностью —  ${}^{171}$ Yb<sup>3+</sup> (I = 1/2). Спектры ОДЭПР Yb<sup>3+</sup> в кристаллах PbF<sub>2</sub> и CdF<sub>2</sub> имеют отношение сигнал/шум, значительно меньшее по сравнению с CaF<sub>2</sub>, что в основном связано с худшим качеством образцов, и в спектрах наблюдаются линии ОДЭПР только от четных изотопов Yb<sup>3+</sup> (вставка на рис. 5). Значения g-факторов и констант сверхтонкого взаимодействия (СТВ) для состояний  ${}^{2}\Gamma_{7}$  и  ${}^{1}\Gamma_{7}$  представлены в табл. 1. Параметры СТВ основного и возбужденного состояний имеют близкие значения, что находится в согласии с результатами, например, для изоэлектронного иона Tm<sup>2+</sup> в CaF<sub>2</sub> [19,20].

Две наиболее интенсивные линии люминесценции в области частот 9600–9800 сm<sup>-1</sup> (рис. 3) можно соотнести с переходами  ${}^{2}\Gamma_{7} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{8}$  и  ${}^{2}\Gamma_{7} \rightarrow {}^{6}$ . Наиболее интенсивную из данных линий в CaF<sub>2</sub> авторы работы [6] сопоставили с переходом  ${}^{2}\Gamma_{7} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{8}$ , однако переход  ${}^{2}\Gamma_{7} \rightarrow {}^{6}$  остался неопределенным. Для однозначного сопоставления линий люминесценции с переходами на уровни  ${}^{1}\Gamma_{8}$  и  ${}^{6}$  были исследованы угловые зависимости зеемановского расщепления данных линий. Для CaF<sub>2</sub> фрагменты спектров люминесценции при трех ориентациях кристалла относительно магнитного поля представ-



**Рис. 5.** Спектр ОД ЭПР по МЦПЛ  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в CaF<sub>2</sub>, T = 2 K,  $\nu = 9.3635$  GHz. Стрелками показаны линии, соответствующие четным (I = 0) и <sup>171</sup>Yb<sup>3+</sup> (I = 1/2) изотопам Yb<sup>3+</sup>. На вставке представлены фрагменты спектров ОД ЭПР  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> ( $\nu = 9.533$  GHz) и PbF<sub>2</sub> ( $\nu = 9.515$  GHz).



**Рис. 6.** Фрагменты поляризованных спектров люминесценции  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в CaF<sub>2</sub> при селективном возбуждении на частоте 10381 сm<sup>-1</sup> в магнитном поле (поперечный эффект Зеемана) при различных ориентациях кристалла относительно направления магнитного поля. T = 2 K. H = 0 и 2.2 T.

лены на рис. 6. Величины расщеплений и интенсивности зеемановских компонент линии 9737 сm<sup>-1</sup> (рис. 6) имеют явную угловую зависимость, что полностью подтверждает предположение о том, что данная линия соответствует переходу  ${}^{2}\Gamma_{7} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{8}$ , поскольку расщепление квартета  ${}^{1}\Gamma_{8}$  в магнитном поле не изотропно [22]. Для линии 9603 сm<sup>-1</sup> такой зависимости не наблюдается. Это свидетельствует о том, что она не является электронно-колебательным спутником линии 9737 сm<sup>-1</sup> и, следовательно, соответствует переходу между двумя крамерсовыми дублетами ( ${}^{2}\Gamma_{7}$  и  $\Gamma_{6}$ ), величина расщеплений которых в магнитном поле не зависит от ориентации кристалла относительно направления магнитного поля. Спектры аналогичного характера наблюдались также и для CdF<sub>2</sub> и PbF<sub>2</sub>.

Полученные данные на основе формализма, развитого в [8], позволили более надежно и точно определить параметры КП для  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в исследуемых кристаллах (табл. 2).

**Таблица 2.** Параметры (ст<sup>-1</sup>) КП  $B_4$ ,  $B_6$  и спинорбитального взаимодействия  $\xi$  Yb<sup>3+</sup>( $T_c$ ) в MeF<sub>2</sub>

Кристалл	$a_0$	ξ	$B_4$	<i>B</i> <sub>6</sub>
$CdF_2$	5.362	2906	-229	32
$CaF_2$	5.443	2904	-230	25
$PbF_2$	5.901	2907	-196	24.8

Примечание. *a*<sub>0</sub> — постоянная кристаллической решетки (в Å) [23].

# 3. Заключение

Методами ЭПР, магнитооптики, ОД ЭПР проведено комплексное исследование центров  $T_c$  Yb<sup>3+</sup>. Впервые наблюдался спектр ОД ЭПР Yb<sup>3+</sup> в состоянии <sup>2</sup>Г<sub>7</sub> в возбужденном мультиплете <sup>2</sup>F<sub>5/2</sub> и определена константа СТВ для <sup>171</sup>Yb<sup>3+</sup> в CaF<sub>2</sub>. Получены параметры КП  $T_c$  Yb<sup>3+</sup> в CdF<sub>2</sub> и уточнены параметры КП данного ПЦ в CaF<sub>2</sub> и PbF<sub>2</sub>.

Авторы благодарят Р.Ю. Абдулсабирова и С.Л. Кораблеву за предоставление образцов, А.М. Леушина и Б.Н. Казакова за полезные обсуждения.

# Список литературы

- M.L. Falin, M.V. Eremin, H. Bill, D. Lovy. Appl. Magn. Res. 14, 427 (1998).
- [2] О.А. Аникеенок. ФТТ 45, 812 (2003).
- [3] О.А. Аникеенок. ФТТ 48, 1771 (2006).
- [4] J.M. Baker. In: Crystal with eluorine structure / Ed. W. Hayes. Clarendon, Oxford (1974). 341 p.
- [5] J. Kirton, A.M. White. Phys. Rev. 178, 543 (1969).
- [6] D. Kiro, W. Low. Magnetic resonance. Proc. of Int. Symp. on electron and nuclear magnetic resonance. Melbourne (1970).
  P. 247.
- [7] П.П. Феофилов. Опт. и спектр. 5, 216 (1958).
- [8] К.И. Герасимов, А.М. Леушин, М.Л. Фалин. ФТТ 43, 1609 (2001).
- [9] M.L. Falin, K.I. Gerasimov, V.A. Latypov, A.M. Leushin. J. Phys.: Cond. Matter 15, 2833 (2003).
- [10] M.L. Falin, K.I. Gerasimov, V.A. Latypov, A.M. Leushin. Appl. Magn. Res. 26, 617 (2004).
- [11] V.J. Abbruscato, E. Banks, B.R. McGarvey. J. Chem. Phys. 49, 903 (1968).
- [12] P.F. Weller. J. Electrochem. Soc.: Solid State Sci. 114, 609 (1967).
- [13] В.А. Латыпов, М.Л. Фалин. ПТЭ 4, 164 (2001).
- [14] M.L. Falin, K.I. Gerasimov, B.N. Kazakov, M.A. Yakshin. Appl. Magn. Res. 17, 103 (1999).
- [15] S. Geschwind. In: Electron paramagnetic resonance/ Ed. S. Geshwind. Plenum press, N.Y.–London (1972). 575 p.
- [16] J.-M. Spaeth, J.R. Niklas, R.H. Bartram. Structural analysis of point defects in solids. An introduction to multiple magnetic resonance spectroscopy. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg (1992). 367 p.
- [17] Л.В. Зайдель, В.К. Прокофьев, С.М. Раинский, В.А. Славный, Е.Я. Шрейдер. Таблицы спектральных линий. Наука, М. (1977). 800 с.
- [18] B. Bleaney. Proc. Roy. Soc. 73, 939 (1959).
- [19] W. Hayes, P.H.S. Smith. J. Phys. C.: Solid State Phys. 4, 840 (1971).
- [20] T. Kohmoto, Y. Fukuda, T. Hashi. Phys. Rev. B 34, 6094 (1986).
- [21] Б.П. Захарченя, В.П. Макаров, А.В. Варфоломеев, А.Я. Рыскин. Опт. и спектр. 16, 455 (1964).
- [22] J.M. Baker, W.B.J. Blake, G.M. Copland. Proc. Roy. Soc. A 309, 119 (1969).
- [23] J.M. Baker. J. Phys. C: Solid State Phys. 12, 4039 (1979).